23

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-153743

(43)Date of publication of application: 27.06.1988

(51)Int.CI.

G11B 7/24 G11B 7/26

.....

(21)Application number : 62-167842

(71)Applicant: HITACHI MAXELL LTD

(22)Date of filing:

07.07.1987

(72)Inventor: IIDA TAMOTSU

HIROSE ATSUKI

(30)Priority

Priority number: 61160712

Priority date: 10.07.1986

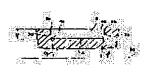
Priority country: JP

(54) OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM AND ITS PRODUCTION

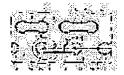
(57)Abstract:

PURPOSE: To sharpen the edge of a reading out signal and to improve recording density by increasing the angle between the bits of a recording medium and the bit forming face of a front face substrate and the angle between ther rear faces of the bits and the bit forming face of the substrate to the angle larger than the angle between the bit side faces in the central part of the bits and the bit forming face of the substrate.

CONSTITUTION: The bit 3 are disposed in a bit array 2 corresponding to one face of the disk substrate 1. The angle between the front end parts 3a of the respective bits 3 constituting the bit array 2 and the bit forming face 1a of the substrate 1 is designated as θ 1 and the angle between the rear end parts 3b of the respective bits 3 and the forming face 1a of the substrate 1 is designated as θ 1. The respective angles θ 1 are selected at the angle larger than the angle θ 2 between the side faces 5c of the bit 3 in









the central part 3c with respect to the scanning direction of the radiation beam of the bit 3 and the forming face 1a of the substrate 1. The angle between the front part 5a of the bit 3 and the forming face 1a of the substrate 1 and the angle between the rear face 5b of the bit 3 and the forming face 1a of the substrate 1 are set at 60W80° to decrease jitters.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-153743

 \mathfrak{gInt}_{Cl}^4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)6月27日

G 11 B 7/24 7/26 B-8421-5D 8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全12頁)

図発明の名称 光情報記録媒体及びその製造方法

②特 願 昭62-167842

愛出 願 昭62(1987)7月7日

度尤惟土版 安阳01(1500)7月10日每日本(JF)到行旗 阳01 100/12

②発 明 者 飯 田 保 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社 内

⑫発 明 者 広 顔 篤 樹 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社

内

⑪出 顋 人 日立マクセル株式会社

大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

冗代 理 人 弁理士 武 顕次郎

明如香

1. 発明の名称

光情報記録媒体及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板の片面に記録信号に対応した配列のピット列を有する光情報記録媒体において、上記・ト列を構成する各ピットの前面と基板のピットの 故面とのなす角度、及びピットの後面と基板のピット形成面とのなす角度が、ピットの放射線ピーム走査方向の中央部における側面と基板のピット形成面とのなす角度より大きい角度に形成されていることを特徴とはなる
- (2) 基板の平面側から観察したとき、ピットの前端部及び後端部が、当該ピットの放射線ピーム走査方向の中央部よりも幅広に形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の光情報記錄媒体。
- (3) 基板の平面側から観察したとき、ピットの前端部から後端部までほぼ同一幅に形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の

光情報記錄媒体。

- (4) ピット艮が再生用放射線ビームの直径よりも 短かいピットを有することを特徴とする特許請求 の額囲第(1)項記載の光情報記録媒体。
- (5) 再生用放射線スポット径よりも短かいピット 長を有するピットの関ロ面における前端部及び後端部の幅を、再生用放射線スポットの直径よりも 長いピット長を有するピットの関ロ面における前端部及び後端部の幅よりも幅広に形成したことを 特徴とする特許請求の範囲第(4)項記載の光情報 記録媒体。
- (6) 再生用放射線スポット径よりも短かいピット 艮を有するピットの底面における前端部及び後端 部の極を、再生用放射線スポットの直径よりも長いピット長を有するピットの底面における前端部 及び後端部の幅よりも幅広に形成したことを特徴 とする特許請求の範囲第(4)項記載の光情報記録 媒体。
- (7) 再生用放射線スポット径よりも短かいビット 艮を有するピットの開口面における中央部の幅を、

再生用放射線スポットの直径よりも良いピット良を有するピットの開口面における中央部の幅よりも幅広に形成したことを特徴とする特許請求の範囲第(4)項記載の光情報記録媒体。

- (8) 再生用放射線スポット径よりも短かいピット 艮を有するピットの底面にむける中央部の幅を、 再生用放射線スポットの直径よりも長いピット 長 を有するピットの底面における中央部の幅よりも 幅広に形成したことを特徴とする特許請求の範囲 第(4)項記載の光情報記録媒体。
- (9) 再生用放射線スポットの直径よりも短かいピット 及を有するピットの開口面の面積を、再生用放射線スポットの直径よりも及いピット 及を有するピットの開口面が再生用放射線スポットに占める面積とほぼ同等に形成したことを特徴とする特許求の範囲第(4)項記載の光情報記録媒体。
- (10) 再生用放射線スポットの直径よりも短かい ピット長を有するピットの底面の面積を、再生用 放射線スポットの直径よりも長いピット長を有す るピットの底面が再生用放射線スポットに占める

るピットを露光する際よりも高強度の放射線ピームを照射するようにしたことを特徴とする特許語 求の範囲第(12)項記載の光情報記録媒体の製造 方法。

(14) 記録用放射線ビームとして、スポット形状が走査方向に直角な方向に延びる楕円形の放射線ビームを用いたことを特徴とする特許請求の範囲第(12)項記載の光情報記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、放射線ビームを照射することによつ て情報の記録再生を行う光情報記録媒体と、この 情報記録媒体の製造方法とに関する。

〔従來の技術〕

例えば追記型光デイスクや書き換え型光デイスクなどの光情報記録媒体は、ガラスや硬質プラスチック等によつて形成された基板の片面に記録信号 (例えば、情報信号やアドレス信号) をピット (例えば、くぼみ) の形で記録したものであつて、このピットの配列を光学的に検出することによつ

面積とほぼ同等に形成したことを特徴とする特許 請求の範囲第(4)項記載の光情報記録媒体。

- (11) ピットの長手方向が再生用放射線ビームの 走査方向と直角に向けられたピット列を有することを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の光 情報記録媒体。
- (12) 表面にホトレジスト層が形成された原盤に記録信号によつて変調された放射線ピームを照射することによつて当該記録信号に対応した配列のというを露光する工程を有する光情報記録媒体のジントを認力して、上記記録信号の立上りエッジ及び立下りエンジに対応において、上記立上のでは立てのかりエッジのが立ていませたが表記を開きます。 対線ピームを照射するようにしたことを特徴とする光情報記録媒体の製造方法。
- (13) 再生用放射線スポットの直径よりも短かい ビット長を有するピットを購光する際に、再生用 放射線スポットの直径よりも長いピット長を有す

て記録された情報信号を再生するようになつてい 。

即ち、光情報記録媒体の記録面には、第11回 に示すように、記録信号(a)をリミツタにかけて 得られるリミツタ波形(b)の立上りの位相に対応 する前端と立下りに位相に対応する後端とを有す るピット(c)が連続して形成されており、このピ ツト列に沿つて再生用放射線ピームを照射するこ とによって、ビツトがある部分とない部分の反射 光の強さの差を利用してピントの前端と後端を検 出し、この信号からリミツタ波形を得て記録信号 を読み出すようになつている。この過程をより詳 雄に説明すると、ピツトがない部分においては、 第12図(a)に示すように、再生用放射線ビーム 40は光情報記録デイスクの背面に形成された反 **料聰(図示せす)にて全反射され、全光束が対物** レンズ41の間口内に戻される。また、ピツトが ある部分においては、第12図(b)に示すように、 再生用放射線ビーム40はピツト42にて回折さ れて反射角度の大きい回折光束43を生じ、これ

らの大部分は対物レンズ41の開口外に外れて、 結果的に当該対物レンズ41に戻つてくる光東の 光量が減少する。更に、上記対物レンズ41の開 口内に戻つてきた光東にピット42の干渉効果に よる光量減少が加算される。このような光量変化 をホトダイオードなどの検出器にて検出すること によつて、ピット42の有無及その及さの変化を 検出して光情報記録媒体に記録された情報を読み 出すことができる。

尚、ピットがある部分の反射光量はピットのサイズに関係し、詳細な計算は省略するが、基板の租折率をn.、再生用放射線ビームの波長を2とした場合、ピットの深さがm2/4n.(但ボットの直径が再生用放射線スポットの直径の約1/3のときにピットとうスポットの直径の約1/3のときにピットと対象スポットの直径の約1/3のときにピットと対象ンドが最大になる。よつて、CN比が最も良好な再生信号を得ることができる。

ところで、かかる光情報記録媒体は、該光情報

実際には放射線スポット 4 3 内の強度分布は均一でなく、中央部が強く周辺部に至るに従つて弱くなるガウス分布になつているため、放射線スポット 4 3 の照射始端 A 及び照射終端 D においては一層ホトレジストの露光量が小さくなる。

ホトレジストにカツテイングされるピツトの大きさ及び深さは、ホトレジストに照射された放射 線ピームの露光量に略比例するため、上記のよう 記録媒体に形成されるべきピットと略同一の凹凸が形成された原盤から転写技術によつて複要はなる。原盤に上記ピットをカッティングするるほと、表面にホトレジストが均一の厚さに配置された原盤を駆動し、該原盤と対向に配置されたカッティングヘッドにで調されたか射線ピームの照射パターンに対応した形状のピットを露光する方法が知られている。

さらに、光情報記録媒体が過記型光デイスクや 書き換之型光デイスクなどのデイスク状光情報記 録媒体であつて、角速度一定で情報の記録、再生 を行うものである場合には、原盤を定角速度にて 回転駆動しつつカツテイングヘッドを原盤の内局 から外周に順次移送してホトレジストの露光を行うが、カツテイング部の半径領域にかかわらず一 定強度の放射線ピームを照射すると、外周に至る に従つて原盤の周速が速くなるため、ホトレジス トの露光量が比例的に低下し、形成されるピット の幅が幅狭化するという問題を生じる。

従来はかかる不具合を防止するため、第17回に示すように、基板の回転中心から放射線スポットの照射位置までの距離に比例して放射線ビームの強度を順次上昇するといつたカツテイング方法が採られている。これによつて、ピット形成の半径領域にかかわらず、ほぼ一定幅のピットが形成できるようになつている。

[発明が解決しようとする問題点]

叙上のように、ピット形成部におけるピット部とランド部からの再生用放射線ビームの反射光量 差、即ち再生信号のCN比は、ピットの形状(深 さ及び幅)が特定の値に形成されている場合に最 大となる。従つて、第15回に示したように、ピ ットの深さが再生用放射線ビームの走査方向に関

り及び立下りがなまるといった問題を解消することができる。しかしながら、この高強度のカンテイング用放射線ビームを照射始端Aから照射終ビームを照射始端Aから照射線ビームを照射始端Aから開領域における幅が再生用放射線スポット径に対する最適幅よりも大きくなつてCN比の低下をきたし、また、ビットの小型化、記録密度の向上という技術的課題にも反することになる。

本発明の目的は、前記した従来技権の諮問題を 解決し、再生特性が良好でかつ記録密度の高い光 情報記録媒体を提供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本発明は、かかる目的を達成するため、基板の 片面に記録信号に対応した配列で形成されるピットの前面と基板のピット形成面とのなす角度、及びピットの後面と基板のピット形成面とのなす角度が、ピットの放射線ビーム走査方向の中央部における側面と基板のピット形成面とのなす角度より大きい角度になるようにしたことを特徴とするものである。 して徐々に深くなるように形成された場合、第18 図に示すように、これから読み出される信号の波 形 4 5 が理想的なパルス波形 4 6 に対して立上り エッジ及び立下りエッジがなまつた形になる。こ のため、読み出し信号のジッタが大きくなるとい つた問題を生じる。

特に、第19回に示すように、ビット長が再生 用放射線スポット径よりも短かいピットについて は、ビット44が再生用放射線スポット43に占 める面積が、再生用放射線スポットに占める面積にい ピットが再生用放射線スポットに占める面積に比 べて小さくなり、再生出力信号レベルの底 ばかりでなく、最も再生出力信号レベルの ばかりでなく、最も再生出力信号レベルの の 記み出しが困難になるという問題を生じる。

尚、強度の高いカツテイング用放射線ビームを 用いてホトレジストを露光すれば、ピット44の 前端部44a及び後端部44bにおける形状をシ ヤーブに形成することができ、ピットの前端部44 a及び後端部44bにおける読み出し信号の立上

また、表面にホトレジスト増が形成された原盤に記録信号によつて変調されたレーザピームを照射することによつて当該記録信号に対応した配列のピットを露光する際、上記記録信号の立上リエッジ及び立下リエッジに対応して照射したリエッジ及び立下りましたローザピームを照射するようにしたことを製造して特徴とするものである。

(作用)

ビットの形状を叙上のように形成すると、当該ビットから読み出される再生信号のピットの立下りと立上りのなまりの程度が小さくなり、ジッタが低減されて再生特性の向上を図ることができる。また、ビット長が再生用レーザスポットよりも短かいピットからもその長さに比例した情報を読み出すことが可能になるので、記録密度の向上が図られる。

〔実施例〕

第1 図乃至第5 図は本発明の第1 実施例図であって、1 は基板、2 は記録信号に対応して配列されたピット列、3 は上記ピット列 2 を構成する各ピットを示している。

基板1は、例えばガラスやマイカなどのセラミ ツクス、PC(ポリカーポネート)、PMMA (ポリメチルメタクリレート)、ポリメチルペン テン、エポキシなどのプラスチツクス、あるいは アルミニウム合金などの金属等によつて形成され る。これら基板1へのピット列2の転写手段とし ては、基板材料に適応した適宜の手段が適用され る。例えば、基板1がセラミックス製や金属製で ある場合には、基板1に転写すべき所望の信号パ ターンの反転パターンが形成されたスタンパと呼 称される金型と基板との間で光硬化性樹脂を展伸 し、信号パターンが転写された光硬化性樹脂を基 板 1 側に付着する所謂 2 P 法が適す。また、基板 1 が P C や P M M A などの熱可塑性のプラスチツ クスにて形成される場合には、キヤビティの片面 が上記スタンパにて形成された金型内に溶融プラ

のなす角度 θ 1 は、ジツタ低減の観点からは 9 0 度に近いほど好ましいが、実用上 6 0 度 ~ 8 0 度に形成されれば足りる。これに対し、ピツトの側面 5 c と基板 1 のピツト形成面 1 a とのなす角度 θ 2 は、光検出器においてそれが連続したデータであると検知されれば足りるのであつて、実用上 4 5 度 ~ 5 6 度程度に形成すれば足りる。

尚、上記ピット3の深さDは、再生信号レベルを最大にするため、再生用放射線ビームの波艮を 2、基板1の屈折率(透明基板の場合)をn1と した場合、m2/4n1(mは整数)の深さに形 成される。

上記ピット3の平面形状は、第3図に示すように、ピット3の前端部及び後端部をさらに強調するため、前端部と後端部をその中間部に比べて幅広に形成することができるし、また、第4図に示すように、ピット3の前端部から後端部までほぼ同一幅に形成することもできる。いずれの場合にも、ピット3の前面5aと後面5bと側面5cとがそれぞれ斜面にて形成されるため、基板1の平

スチックスを高圧で射出する射出成形法が適す。 さらに、基板 1 がエポキシなどの熱硬化性のプラスチックスにて形成される場合には、キャビティの片面が上記スタンパにて形成された金型内に液 状プラスチックスを節注する注型法が適する。

面側から観察したとき、ピット3の底面4がピット3の開口面の形状の内周に観察される。

ピット3の横幅は、当該ピット3から読み出さ れる再生信号レベルを最大にするため、再生用放 射線スポット径の約1/3の幅に形成される。こ の場合、ピット3の開口面における寸法を叙上の ように形成することもできるし、また、底面にお ける寸法を叙上のようにすることもできる。さら に、ピットの平面形状が第3図のようなものであ る場合には、幅広に形成された前端部及び後端部 の幅を再生用放射線スポット径の約1/3の幅に 形成することもできるし、幅狭に形成された中間 部の幅を再生用放射線スポット径の約1/3の幅 に形成することもできる。尚、再生信号レベルを 最大にすると共に、情報の記録密度を最大にする ためには、ピット3の底面の前端部及び後端部の 幅を再生用放射線スポット径の約1/3の幅に形 成することが最も好ましい。

以下に、第3図のような平面形状を有し、 1.6 μmの再生用放射線スポットが適用されるピット の各部の寸法の一例を掲げる。 尚、 W 1 は関口面における前端部3 a 及び後端部3 b の幅、 W 2 は底面における前端部3 a 及び後端部3 b の幅、 W a は開口面における中央部3 c の幅、 W・ は底面における中央部3 c の幅、 s は前端部3 a 及び後端部3 b の長さである。

 $W_1 = 0 . 5 2 \sim 0 . 5 8 \mu m$ $W_2 = 0 . 4 0 \sim 0 . 4 4 \mu m$ $W_3 = 0 . 5 2 \sim 0 . 5 5 \mu m$ $W_4 = 0 . 3 5 \sim 0 . 3 8 \mu m$ $S_5 = 0 . 3 5 \sim 0 . 4 5 \mu m$

上記ピット3の長さは、再生用放射線スポット 怪よりも長くすることもできるし、また、記録帘 度を高密度化するため、第5回に示すように、再 生用放射線スポット径 d よりも短かくすることも できる。この場合、1つの記録媒体中に再生用放 射線スポット径よりも長いピットと短かいピット を混在形成することもできる。

勿論、ピット長が再生用放射線スポット径 d よりも短かいピットについても、ピット 3 の前面 5

も 長いピットが再生用放射線スポットに占める割合と略等しくなるようにすることが好ましい。

この場合、再生用放射線スポント径 d よりも短 かいピット及を有するピットの開口面における前 端 部及び後端部の幅を、再生用放射線スポット 6 の直径よりも長いピット及を有ずるピットの開口 部における前端部及び後端部の幅よりも幅広に形 成することもできる。また、再生用放射線スポツ ト径dよりも短かいピツト長を有するピツトの底 面 部における前端部及び後端部の幅を、再生用放 射線スポツトの直径よりも長いピツト長を有する ピットの底面部における前端部及び後端部の幅よ りも幅広に形成することもできる。また、再生用 放射線スポット径よりも短かいピット及を有する ビットの開口部における中央部(長手方向、即ち 放射線ピームの走査方向に関する中央部)の幅を、 再生用放射線スポットの直径よりも長いピット長 を有するピットの開口部における放射線ビームの 中央部の幅よりも幅広に形成することもできる。 さらには、再生用放射線スポット径よりも短かい

aと基板1のピット形成面1 aとのなす角度、及びピット3の後面5 bと基板1のピット形成面1 aとのなす角度θ1 は、ピット3の側面5 cとり状をい角度に形成面1 aとのなす角度θ2 より大きい角度に形成される。また、ピット3の深さに形成される。さらにないは、λ/4 n1 の深さに形成される。さらにないは、2/4 n1 の深さに形成される。さらにないようたん形に形成することもできるし、また。第4 図に示すような形状に形成することもできる。

ビット 長を有するビットの底面部における中央部の幅を、再生用放射線スポットの直径よりも長い ビット 長を有するビットの底面部における中央部 の幅よりも幅広に形成することもできる。

以下に、第5回のような平面形状を有し、 1.6 μmの再生用放射線スポットが適用されるピットの各部の寸法の一例を掲げる。 尚、 W s は開口面にむける前端部3 a 及び後端部3 b の幅、 W s は中央部にむける開口部の幅、 W s は中央部にむける底面部の幅である。

W s = 0 . 5 2 ~ 0 . 5 8 μ m W c = 0 . 4 0 ~ 0 . 4 4 μ m W 7 = 0 . 4 8 ~ 0 . 5 8 μ m W 8 = 0 . 3 6 ~ 0 . 4 4 μ m

このようにして、再生用放射線スポットの直径 よりも短かいピット長を有するピットの開口面の 面積または底面の面積を、再生用放射線スポット の直径よりも長いピット長を有するピットの開口 面が再生用放射線スポットに占める面積と同等に 形成することができる。

尚、上記実施例においては、トラツキング情報に対応するプリグループ(案内溝)が形成されていない光情報記録媒体について説明したが、本発明の要旨はこれに限定されるものではなく、プリグループを有する光情報記録媒体についても全例においては、ピット3の底面の深さが一様に形成された所謂底切りの光情報記録媒体について説明

17は記録信号源16の処理回路、18は反射鏡、19はビームエキスパンダ、20は第2の放射線光源、21はハーフミラー、22はビーム合成プリズム、23は反射鏡、24はカツテイングへツド、25はカツテイングへツド24に饋えられたホーカスアクチュエータ、26はカツテイングへツド24に饋えられた対物レンズ、27はホーカスアクチュエータを制御するホーカス制御回路である。

上記第1の放射線光源12は、光デイスク原盤10に塗布されたホトレジストの露光用として用いられ、このホトレジストの感光域外の波長を有する第2の放射線光源20は上記ホーカスアクチュエータ25の自動焦点調整に用いられる。

A - O 光変調器 1 3 は、第 7 図に示すように、例えば LiNbOs などの圧電体 2 8 に周波数 f の電圧を印加して、TeOz、PbMoO4 などの媒質 2 9 中に波長 2 の疎密波 3 0 を発生させ、これを回折格子として信号波を回折させるものであって、超音波駆動電圧を提幅変調することによって、

したが、本発明の要旨はこれに限定されるものではなく、原盤をカツテイングする際、ホトレジストをカツテイング用放射線ピームの露光深度よりも充分に厚く形成し、ピツトの底面が曲面状に形成されたものについても同様に実施することができる。

ピット3の前端部3 a 及び後端部3 b の幅、及びピット3の前面5 a 及び後面5 b の傾斜角度、それにピット3の中間部3 c の幅、及びピット3の側面5 c の傾斜角度は、光デイスク原盤をカッティングする際に、ホトレジストの欝光量(放射線光強度)を調整することによつて調整することができる。以下、光デイスクを例にとつて、原盤のカッティング装置、及びこれを用いたピット露か方法の一例について説明する。

第6回は原盤カツテイング装置の全体の構成を示す斜視図であつて、10は原盤、11はターンテーブル、12は第1の放射線光源、13はA-〇光変調器、14は反射鏡、15はE-〇変調器、16はE-〇変調器15に加えられる記録信号源、

変調光31を得るようになつている。 従つて、 A - O光変調器13の超音波駆動電圧を振幅変調することによつて、光デイスク原盤10に形成されたホトレジストの露光量を調整することができる。

E-O光変調路 1 5 は、第 8 図に示すように、ポッケルスセル 3 1 a に世圧を加えて結晶の屈折 事権円体の主軸との間に異方性を生じ、結晶内を 進む 2 つの直線偏波間に世界の強さに比例した位相 速度の 芝を生じる現象を利用するものであつて、ポッケルスセル 3 1 a から出る 楕円偏光 3 2 を アナライザ 3 3 を介して取り出し、 振幅変調された 光 3 4 を 得るようになつている。

ビームエキスパンダ 1 0 は一種のコリメータであつて、カツテイングヘッド 1 5 に備えられた対物レンズ 1 7 の開ロー杯にビームを入射させるために、ビーム径を広げるようになつている。

かかるカツテイング装置によつて光デイスク原盤をカツテイングする場合には、ターンテーブル 1 1 を回転駆動して未記録の光デイスク原盤 1 0 を定角速度回転し、該未記録光ディスク原盤 1 0

の表面に形成されたホトレジストに、前記A-O 光変調器13の超音波駆動電圧を振幅変調するこ とによつて所要の強度にビームを照射する。即ち、 第9図(a)に示すように、記録信号35の立上り エッジ35aと対応する放射線ビームの照射始端 Aにおいて瞬間的に強度Pıの放射線ピームを照 射し、直ちに放射線ビームの強度を上記初期放射 線ビームの強度P」よりも弱めて記録信号の立上 りエツジ35aから立下りエツジ35bまでの間 を強度Pzにて露光し、最後に記録信号の立下り エツジ35bと対応する放射線ビームの照射終端 Dにおいて、上記初期放射線ビームと同じ強度 P」の放射線ビームを照射してホトレジストのカ ツティングを行う。上記初期放射線ビームの強度 P1及び中間の放射線ビームの強度 P2は、第9 図(b)に示すように、放射線スポット36の照射 始端Aからスポツト径dだけ離隔した位置Bのホ トレジスト層の露光量、及び放射線スポツト36 の照射終端Dからスポット径 dだけ離隔した位置 Cのホトレジスト暦の露光量が、所定の幅のピツ

トをカッテイングするに足る護光量になるように 調整される。例えば、同一感度のホトレジストを 博光することによつて一定強度の放射線ビームを 一定線速度でトレースした 合と同一幅ののピピア を形成する場合には、放射線スポット36の照射 始端Aからスポット径はだけ離隔した位置B及び はだけ離隔した位置Cのホトレジスト層の露出 はだけ離隔した位置Cのホトレンスト層の露速に のは、からないなりには、ないないないでは はだければいる。と略等しくなる ように調整される。

また、再生用放射線スポット径よりも短かいピット艮のピットをカッティングする場合には、ピットの幅を再生用放射線スポット径よりも長いピットに比べて幅広に形成するため、上記と同様の露光手段において、より高強度の放射線ビームが照射される。

上記の露光方法によると、放射線スポットの照射始端Aから放射線スポットの直径 d だけ離隔した位置B及び照射終端Dから放射線スポットの直

径 d だけ離隔した位置 C においては初期放射線ビ ームによる離光量と強度Pzの放射線ビームをス ポット径 d だけトレースすることによる露光量と が加算されるのでホトレジストの露光量が大きく なつて、幅広にして前面5 a 及び後面5 b の傾斜 角がシャープな前端部3a及び後端部3bを形成 することができ、また、その中間部では低強度の 放射線スポットを照射するので露光量が小さくな つてピット幅が輻狭になる。この場合、放射線ビ ームの強度Pェ、Pzを放射線スポットの照射始 端Aからスポット径dだけ離隔した部分Bの離光 量Q1が一定強度の放射線ピームを一定線速度で トレースした場合の露光量Qzと略等しくなるよ うに調整すると、前端部3 a 及び後端部3 b の幅 が一定強度の放射線ビームを一定線速度でトレー スすることによつて形成されるピツトのピツト幅 と略同じ幅になり、記録密度が低下することがな い。尚、ピツト3の中央部3cは、放射線スポツ トの照射始端Aの蔵光量Q。と該部から放射線ス ポツトのスポツト径はだけ離隔した位置Bの露光

量Q」との差分の韓光量で韓光される。

本発明の光情報記録デイスクは、上記のように してピットが露光された光デイスク原盤から転写 技術によつて複製される。

尚、本発明の要旨は、ピットの前端部と後端部の断面形状をシャープにする点に存するのであつて、放射線ビームの照射始端Aから照射幹線ビームの開射始端を適宜調整するの中間における放射線ビームの側面の傾斜をピット3の中間のは斜と同一にすると共に、射が端との中間部3cの幅を照射始端A及び照射のよいをはたけ離隔した位置C。Dにおけるピット幅と同一幅に形成することもできる。

また、本発明の光情報記録媒体は、光デイスクのみならず、光カードや光テープなど、任意の光情報記録媒体に適用することができる。第10回は光カードの一例を示す正面図であつて、カード本体37の長手方向に磁気ストライプ38と光記録ストライプ39とが平行に形成されており、この光記録ストライプ39にピツト列2が形成され

ている。本実施例に示すように、ピット3の平面 形状を、再生用放射線ビームの走査方向と直角の 方向に延びる矩形または楕円形に形成することも できる。

勿論、カツテイング装置については上記実施例に示したものに限定されるものではなく、この他、公知に属する任意のカツテイング装置を適用することができる。また、第10図に示したように、再生用放射線ビームの走査方向と直角の方向に延びる矩形のピット3をカツテイングするに際しては、スポット形状が走査方向と直角の方向に延びる矩形または楕円形の記録用放射線ビームを用いることができる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明の光情報記録媒体は、ピットの前面と基板のピット形成面とのなす角度、及びピットの後面と基板のピット形成面とのなす角度を、ピットの中央部におけるピットの側面と基板のピット形成面とのなす角度よりも大きい角度に形成したので、該ピットから読み出さ

第6回は光デイスク原盤カツテイング装置の全体 の構成を示す斜視図、第7図はA-〇光変調器の 原理を示す斜視図、第8回はE一〇光変調器の原 理を示す斜視図、第9図(a), (b)は記録信号の 立上りエツジ及び立下りエツジと、光ディスクに 照射される放射線ピームの強度と、ホトレジスト の露光量との関係を示すグラフ、第10回は本発 明を光カードに応用した場合の実施例を示す平面 図、第11図は記録信号と光情報記録媒体に形成 されるピツトの関係を示す説明図、第12図(a) (b)は光情報記録媒体の再生原理を示す斜視図、 第13回は一定強度の放射線スポットを一定線速 度でトレースしたときのホトレジストの露光強度 の変化を示すグラフ、第14回は従来の光情報記 緑媒体に形成されているピツトの餌面形状を示す 断面図、第15回は従来の光情報記録媒体に形成 されているピツトの前面及び後面の形状を示す断 面図、第16図は従来のピツトの平面形状を示す 平面図、第17図は従来の韓光方法におけるディ スク半径と露光強度との関係を示すグラフ、第18

れる読出し借号の立上リエンジ及び立下リエンジがシャープになり、読出し借号のジンタを減少することが、再生用放射は、ピットについてはよりも短かいピットについたみ出すでは、メット径よりも長いピットを読み出する。 は、できる。よって、ピットの短縮化を図ることができ、記録密度が向上する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る光情報記録媒体に形成されるピットの放射線ビーム走査方向の断面形状を示す要部断面図、第2図は第1図のピットの放射線ビーム走査方向と直角の方向の断面形状を示す要部断面図、第3図は本発明に係るピットの平面図、第4図は本発明に係るピットの他の例を示す要部平面図、第5図は再生用放射線スポット程よりも短かいピット長を有するピットの平面形状の一例を示す要部平面図、

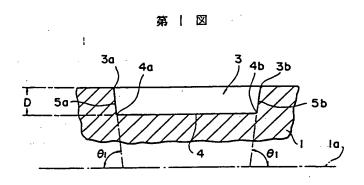
図は従来のピットから読み出される再生信号特性を示すグラフ、第19回は再生用放射線スポット 径よりも短かいピット長を有する従来のピットの 平面形状を示す平面図である。

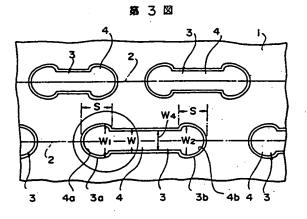
1:デイスク基板、1 a:ピット形成面、2:ピット列、3:ピット、3 a:前端部、3 b:後端部、3 c:中間部、4 a, 4 b:底面、5 a:前面、5 b:後面、5 c:側面、1 0:光デイスク原盤、1 2:第1の放射線光源、1 3:A-O光変調器、1 5:E-O変調器、1 6:情報信号源、20:第2の放射線光源、22:ピーム合成プリズム、24:対物レンズ

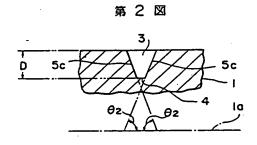
代理人升理士 武 颁次负

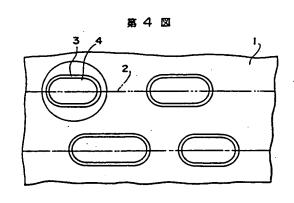


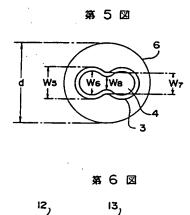
特開昭63-153743 (10)

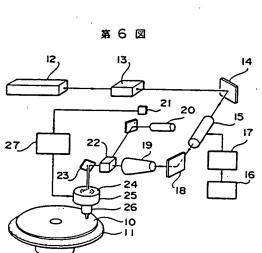


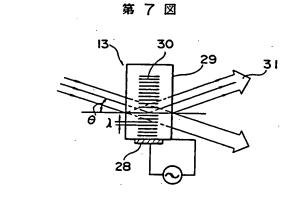


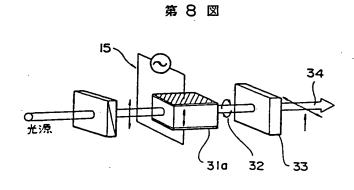


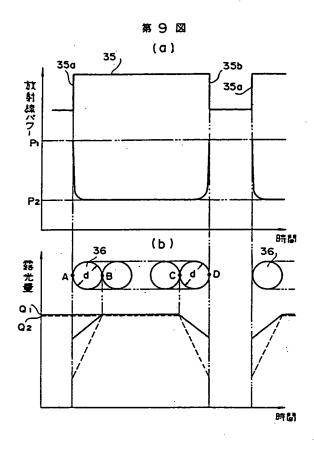


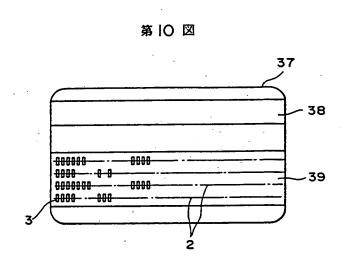


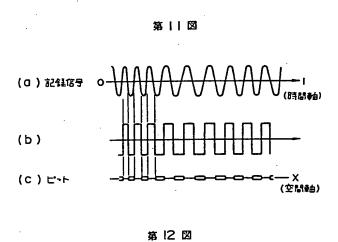


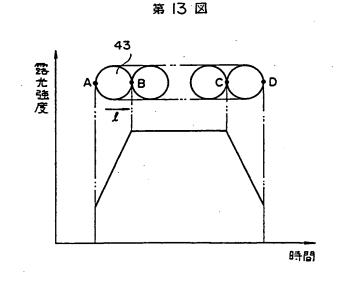


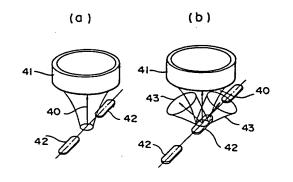


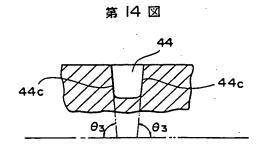




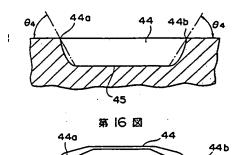


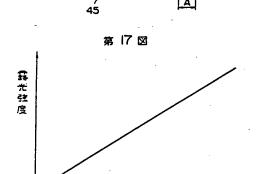






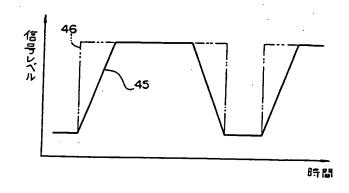
第 15 図





ディスクキ径

第18 図



第 19 図

